



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و
فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۵-۱۶ بهمن ۱۳۹۸



مدولاتور الکترواپتیکی چند بانده مبتنی بر گرافن در بازه مادون قرمز میانی

ابوالفضل صنعتی^۱، بهنام جعفری^۱، هادی صوفی^۱

^۱دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱، ایران

چکیده- در این مقاله یک مدولاتور نوری مولتی باند در بازه طول موجی مادون قرمز میانی مبتنی بر گرافن تک لایه طراحی و مدل سازی شده است که در آن نانو آنتن های فلزی برای جذب و بهبود مشخصات مدولاتور قرار گرفته است. بیشتر مدولاتورهای الکترواپتیکی مبتنی بر گرافن بر مبنای تغییر در مقدار جذب توسط دوپینگ الکترواستاتیکی از طریق الکتروگیت هستند که به دلیل کم بودن مقدار جذب مطلق گرافن، برای عملکرد مناسب عموماً نیاز به ولتاژ عملکرد بالا داشته و پاسخ دهی آن ها برای ولتاژهای پایین بسیار کم است. در این مقاله یک مدولاتور الکترواپتیکی مبتنی بر گرافن طراحی شده است که عمل مدولاسیون بر اساس تداخل فابری-پرو بین امواج پلاسمونی رونده و برگشتی گرافن در یک ساختار فلز-دی الکتریک-گرافن-فلز بوده و با اعمال کوچکترین ولتاژ عمق مدولاسیون تقریباً ۱۰۰٪ به دست می آید. برای دو طول موج $6\ \mu\text{m}$ و $7.5\ \mu\text{m}$ عمق مدولاسیون بترتیب ۷۰ و ۸۵ درصد و تلفات الحاقی آنها بترتیب $2.21\ \text{dB}$ و $0.8\ \text{dB}$ بدست آمده است. در این مدولاتور، ماده ی گرافن نه به عنوان یک ماده ی جاذب بلکه برای شیفت فرکانس رزونانس ساختار فابری-پرو استفاده می شود. در این پژوهش نور انعکاسی از سیستم به عنوان نور مدوله شده در نظر گرفته شده است.

کلید واژه- مدولاتورهای الکترواپتیکی، گرافن، پلاسمونیک، رزونانس فابری پرو، فروسرخ میانی

Multiband Electro Optic modulator Based on Graphene in the Mid-IR wavelength range

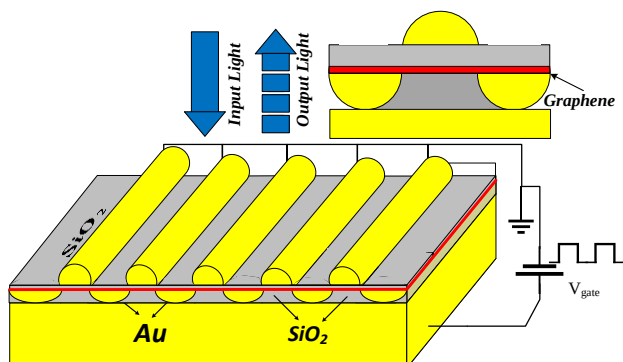
Abolfazl Sanati¹, Behnam Jafari¹, Hadi Soofi¹

Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz 5166616471, Iran

Abstract- In this article a multiband optical modulator based on single layer graphene in the mid-IR wavelength range is designed and simulated. In this modulator metallic nano antennas are utilized to enhance absorption and modulator characteristics. Most of the graphene based electro-optic modulators function according to the modification of absorption with electrostatic doping through gate electrode. Such modulators often require high voltage and have low responsivity for lower voltages due to the low absorption of single layer graphene. In this article, an electro-optic modulator based on graphene is designed at which the modulation principle is Fabry-Perot interference between counter propagating plasmon waves in a metal-dielectric-graphene-metal structure and reaches a modulation depth of nearly 100% with a very small applied voltage. For wavelengths of 6 and $7.5\ \mu\text{m}$, modulation depth of 70 and 85 % are obtained. For these wavelengths insertion loss is 0.8 and 2.21 dB respectively. In this modulator, graphene is employed for absorption, but instead to shift the resonance wavelength of the Fabry-Perot structure. In this article, the reflected wave is considered as the modulated signal.

Keywords: Electro-optic modulators, Fabry-Perot interferometer, Graphene, Mid-IR, Plasmonic.

مقدمه



شکل ۱: شماتیک ۳ بعدی و ۲ بعدی از مدولاتور الکترواپتیکی مبتنی بر گرافن بهبود داده شده با نانو آنتن های فلزی با ساختار ساندویچی فلز/دی الکتریک/گرافن/فلز بهینه شده.

امروزه مدولاتورهای متنوعی در حال گسترش و در سالیان اخیر استفاده از گرافن در مدولاتورهای نوری به دلیل ویژگیهای منحصر بفرد نوری و الکترونیکی که دارد [۱] بیشتر شده و باعث بهبود پارامترهای ساختارهای مختلف می شود. جذب نوری ۲،۳٪ برای گرافن تک لایه یکی دیگر از خواص منحصر بفرد آن است ولی مقدار کلی آن برای ادوات الکترواپتیکی همچون مدولاتور کم بوده بنابراین با توجه به اینکه گرافن در طیف انرژی مادون قرمز میانی از خود پاسخ پلاسمونیکی قوی نشان می دهد، از آن برای ساختن ادوات الکترواپتیکی متعددی همچون آشکارساز و مدولاتور در این طیف انرژی استفاده می شود [۲]. از ساختارهای ساندویچی فلز/دی الکتریک/گرافن ادوات الکترواپتیکی متعددی چون جاذب های نوری و آشکارسازها [۳] ساخته شده اند.

در پژوهش حاضر با استفاده از مزایای گرافن، تحریک امواج پلاسمونی در آن و تداخل فابری پرو بین امواج پلاسمونی قطبیده شده توانستیم با بکارگیری یک لایه ی فلزی منعکس کننده در پایین ساختار که به عنوان الکتروود نیز عمل می کند به طیف نور بازگشتی چند بانده دست بیابیم بطوریکه با تنظیم ولتاژ گیت اعمالی به مدولاتور در هر طول موج دلخواه عمل مدولاسیون با بیشینه عمق مدولاسیون اتفاق می افتد. در این مدولاتور با اعمال ولتاژ بایاس گیت به میزان خیلی کم طیف نور برگشتی از سیستم در حدود بالای ۹۰ درصد تغییر می کند. همچنین مدولاتور طراحی شده دارای سرعت و پهنای باند بالایی بوده (۲/۵THz) و توان مصرفی بسیار کمی خواهد داشت.

طراحی و مدلسازی مدولاتور

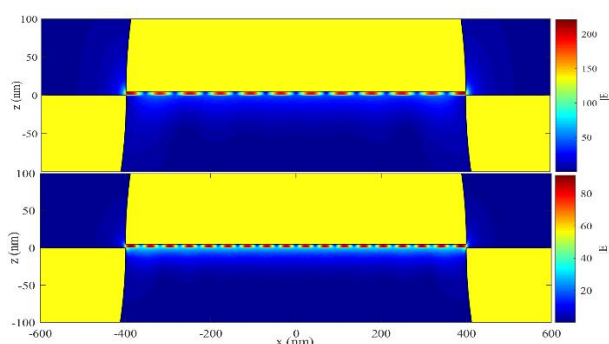
نمای دو و سه بعدی از ساختار در شکل ۱ آورده شده است که متشکل از ساختارهای ساندویچی فلز/دی الکتریک/گرافن/فلز است. نانو آنتن های فلزی در هر دو طرف ساختار بالا و پایین گرافن قرار گرفته اند. یک دی الکتریک با ضخامت ۵nm بین گرافن و نانو آنتن های بالایی قرار گرفته، شعاع نانو آنتن ها ۴۰۰nm است و نانو آنتن های پایینی در دی الکتریک SiO2 به ضخامت ۱۰۰ نانومتر دفن شده اند. گیت فلزی (طلا) به عنوان بازتابنده در زیر ساختار (بستر) به منظور افزایش اندرکنش بین

یک موج تخت با قطبش عمود بر جهت نانو آنتن ها (در جهت X) و جهت انتشار در راستای Z- به مدولاتور تابانده می شود. در این مقاله تحلیل نوری ساختار از طریق روش FDTD انجام شده که در آن گرافن به عنوان یک ماده ی دو بعدی با هدایت سطحی آن متشکل از گذارهای بین بانده و درون بانده با استفاده از فرمول کوپو [۱] مدلسازی شده است. با اعمال نور فرودی به مدولاتور بدلیل متقارن بودن ساختار، امواج پلاسمونی گرافن در دو طرف نانو آنتن ها تحریک شده و در حضور مولفه ی میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی فرودی، این امواج پلاسمونی در جهت x و به سمت هم حرکت می کنند، این عمل باعث تداخل فابری پرو شده و نور برگشتی دارای پیک های متوالی می شود. با اعمال ولتاژ بایاس از طریق الکتروود گیت و دوپینگ الکترواستاتیکی گرافن می توان پیک های طیف بازگشتی را شیفت داد، به طوریکه با اعمال مقدار مناسب و تنظیم شده ی ولتاژ کمینه و بیشینه مقدار در یک فرکانس اتفاق بیفتند که باعث بیشینه شدن عمق مدولاسیون می شود. برای مدلسازی الکترواستاتیکی گرافن از معادله ی زیر استفاده شده است.

$$|\Delta E_f| = \hbar v_f \sqrt{\frac{\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{e d_{ox}} |V_g - V_{dirac}|} \quad (1)$$

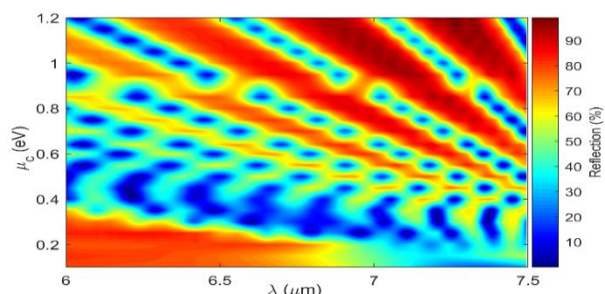
در معادله ی بالا $\epsilon_r = 3.9$ ضریب گذردهی الکتریکی دی الکتریک گیت و ϵ_0 ضریب گذردهی خلاء می باشد. مقدار پتانسیل شیمیایی اولیه گرافن سنتز شده به روش CVD بدلیل واکنش با مولکول های اکسیژن هوا به عنوان گیرنده الکترون عموماً صفر

با افزایش طول شکاف، تعداد پیک‌های نور بازگشتی به دلیل افزایش مرتبه‌ی رزونانس امواج پلاسمونی گرافن، افزایش پیدا می‌کند. اگر m مرتبه‌ی رزونانس باشد $\lambda_{GP} = 2W/m$ طول موج امواج پلاسمونی تحریک شده در سطح گرافن خواهد بود که با افزایش مرتبه‌ی رزونانس کاهش می‌یابد. توزیع میدان الکتریکی در ساختار ساندویچی فلز/دی الکتریک/گرافن/فلز بهبود یافته در شکل ۴ برای دو طول موج متفاوت آورده شده است. با افزایش فرکانس نور فرودی مرتبه‌ی رزونانس افزایش یافته و نحوه‌ی شکل‌گیری امواج ایستا در اثر تداخل فابری پرو مشاهده می‌شود.



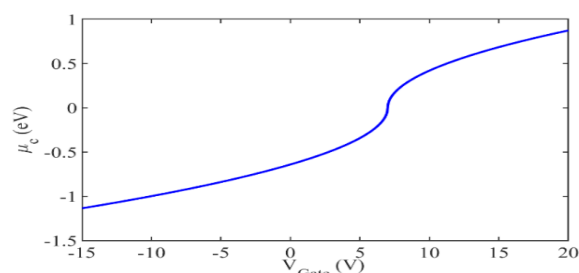
شکل ۴: توزیع میدان الکتریکی در ساختار پیشنهادی. شکل بالایی توزیع میدان در فرکانس ۴۱ تراهرتز است که دارای مرتبه‌ی رزونانس ۱۱ است و متناظر با پیک نور بازگشتی است. شکل پایینی توزیع میدان در فرکانس ۴۸/۲۳ تراهرتز است که دارای مرتبه‌ی رزونانس ۱۸ بوده و متناظر با دره‌ی طیف نور بازگشتی است

طیف نور بازگشتی برحسب پتانسیل شیمیایی گرافن و طول موج نور فرودی برای طول شکاف 800 nm در شکل (۵) آورده شده که در آن شیف‌ت پیک‌های رزونانس به وضوح قابل مشاهده است. با افزایش پتانسیل شیمیایی گرافن مرتبه‌ی رزونانس و به دنبال آن تعداد پیک‌های عبور کمتر می‌شود.



شکل ۵: طیف نور بازگشتی از مدولاتور بر حسب طول موج نور فرودی و سطح پتانسیل شیمیایی گرافن (ولتاژ گیت).

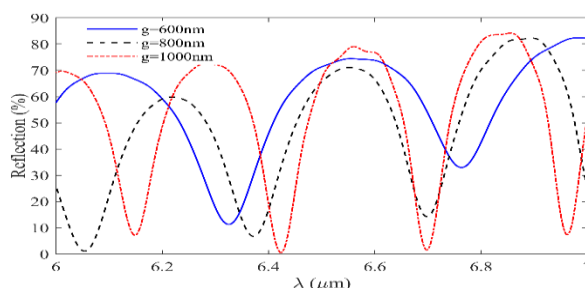
نبوده و مقداری حفره‌ی اضافی دارد [۴]. به همین دلیل در این مقاله مقدار اولیه سطح فرمی برابر با $|\mu_c| = 0.64\text{ eV}$ فرض شده است، بنابراین با این فرض و با در نظر گرفتن ضخامت دی الکتریک ساختار پیشنهادی که برابر با 5 nm است مقدار ولتاژ گیت لازم است تا سطح فرمی به نقطه‌ی دیراک منقل شود برابر با $V_{dirac} = 7\text{ V}$ است. همانطور که در ادامه خواهیم دید برای داشتن بیشینه مقدار عمق مدولاسیون لازم نیست تا سطح فرمی در نقطه‌ی دیراک واقع شود. نمودار سطح فرمی بر حسب ولتاژ بایاس گیت به صورت زیر است:



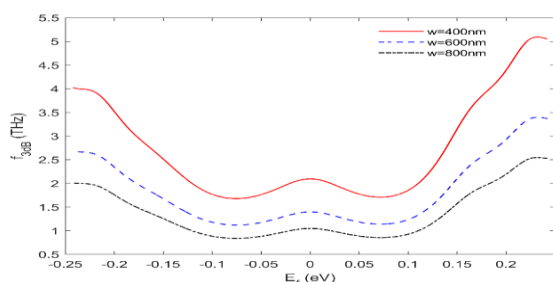
شکل ۶: تغییرات پتانسیل شیمیایی گرافن بر حسب ولتاژ گیت.

نتایج و بحث

اعمال ولتاژ بایاس باعث شیفت یافتن پیک‌های نور بازگشتی از ساختار می‌شود قابل ذکر است، که همانطور که در ادامه خواهیم دید، شیفت پیک‌های تداخل فابری پرو تعیین کننده‌ی حساسیت مدولاسیون است به عبارت دیگر هرچقدر با تغییر ولتاژ گیت شیفت پیک‌ها زیاد باشد حساسیت مدولاتور پیشنهادی نیز زیاد خواهد بود. طیف نور بازگشتی از ساختار در بخشی از بازه‌ی مادون قرمز میانی (۶/۵-۷ میکرومتر) وقتی که $d_{ox} = 5\text{ nm}$ و ولتاژ گیت اعمالی صفر ($E_F = 0.64\text{ eV}$) است برای طول شکاف‌های مختلف در شکل (۳) نشان داده شده است.



شکل ۳: طیف بازگشتی از مدولاتور در بایاس صفر برای طول شکاف‌های مختلف.



شکل ۷: فرکانس قطع ۳dB مدولاتور برحسب سطح فرمی برای طول شکاف‌های مختلف.

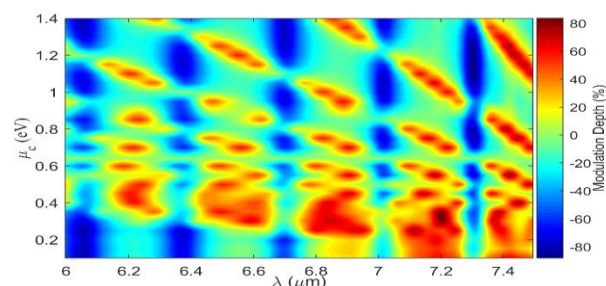
نتیجه گیری

در این مقاله، یک مدولاتور تراهرتز مبتنی بر گرافن مورد طراحی و مدل سازی قرار گرفت. بر خلاف مدولاتورهای گرافنی مرسوم، در این ساختار از شیفت در فرکانس‌های رزونانس در ساختار فابری-پیرو در اثر تغییر در هدایت سطحی گرافن برای عمل مدولاسیون استفاده شده است. مدولاتور طراحی شده، دارای عمق مدولاسیون بسیار زیاد و ولتاژی عملکرد بسیار پایین است. برای دو طول موج $7.5\mu m$ و $6\mu m$ عمق مدولاسیون به ترتیب ۷۰ و ۸۵ درصد و تلفات الحاقی آنها به ترتیب ۲.۲۱ dB و ۰.۸ است. سرعت و پهنای باند مدولاسیون با تحلیل مدار معادل الکتریکی ساختار مورد بررسی قرار گرفته و با کنترل و انتخاب مناسب ابعاد و بهینه کردن آنها سرعت مدولاسیون به بیشتر از $2/5 THz$ رسیده است.

مرجع ها

- [۱] A. Grigorenko, M. Polini, and K. Novoselov, "Graphene plasmonics," *Nature photonics*, vol. 6, p. 749, 2012.
- [۲] N. Jiang, X. Zhuo, and J. Wang, "Active plasmonics: principles, structures, and applications," *Chemical reviews*, vol. 118, pp. 3054-3099, 2019.
- [۳] B. Jafari and H. Soofi, "High bandwidth and responsivity mid-infrared graphene photodetector based on a modified metal-dielectric-graphene architecture," *Applied Optics*, vol. 58, pp. 6280-6287, 2019.
- [۴] H. Liu, Y. Liu, and D. Zhu, "Chemical doping of graphene," *Journal of materials chemistry*, vol. 21, pp. 3335-3345, 2011.

عمق مدولاسیون ساختار در شکل ۶ آورده شده است در حالتی که با اعمال بایاس مرتبه‌ی رزونانس از یک عدد زوج به فرد تبدیل شود عمق مدولاسیون بیشترین مقدار خواهد بود. علامت منفی (نواحی آبی رنگ) در این شکل بیانگر اینست که با اعمال ولتاژ گیت مقدار نور بازگشتی بیشتر از مقدار اولیه‌ی آن (در ولتاژ بایاس صفر) است. همانطور که دیده می‌شود با انتخاب و تنظیم مناسب دامنه‌ی سیگنال اعمالی به مدولاتور می‌توان آنرا برای هر فرکانس دلخواهی با بیشترین عمق مدولاسیون سوار کرد. برای مثال در طول موج $6\mu m$ با اعمال ولتاژ بایاس کوچکی به اندازه‌ی ۱.۴V عمق مدولاسیون به بیش از ۷۰٪ و تلفات الحاقی ۲.۲۱dB می‌رسد. در حالیکه با اعمال ولتاژ $1.8V$ در طول موج $7.5\mu m$ عمق مدولاسیون به بیش از ۸۵٪ رسیده و تلفات الحاقی آن به مقدار خیلی کوچک ۰.۸dB می‌رسد. با توجه به مقدار میدان بحرانی یا (break_down field) دی‌الکتریک استفاده شده در طراحی مدولاتور که برابر با $1 V/nm$ است و مقدار ولتاژ بایاس کمی که برای رسیدن به بیشینه عمق مدولاسیون و تلفات الحاقی کم مورد نیاز است، بنابراین مقدار ولتاژ اعمالی به الکتروود گیت خیلی کمتر از ولتاژ شکست دی‌الکتریک SiO_2 می‌باشد. (برای دی‌الکتریک استفاده شده با ضخامت ۵nm مقدار ولتاژ شکست آن برابر با ۵V می‌باشد)



شکل ۶: عمق مدولاسیون مدولاتور بر حسب طول موج نور فرودی و سطح پتانسیل شیمیایی گرافن.

پهنای باند 3dB از طریق تحلیل مدل مداری و با در نظر گرفتن مقاومت‌ها و خازن گیت و خازن کوانتومی گرافن برای طول شکاف‌های مختلف بصورت زیر در می‌آید: با افزایش سطح فرمی سرعت مدولاسیون نیز زیاد شده بطوریکه در شکاف ۸۰۰nm سرعت مدولاسیون به بیشتر از $2/5$ تراهرتز می‌رسد.